

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

EXPRESS MAIL NO. EV351235255US

Applicant : Oh-Kyong Kwon
Application No. : N/A
Filed : December 4, 2003
Title : LIGHT EMITTING DISPLAY, DISPLAY PANEL, AND DRIVING
METHOD THEREOF

Grp./Div. : N/A
Examiner : N/A

Docket No. : 51070/DBP/Y35

LETTER FORWARDING CERTIFIED
PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

PostOffice Box 7068
Pasadena, CA 91109-7068
December 4, 2003

Commissioner:

Enclosed is a certified copy of Korean Patent Application No. 2003-0020432, which was filed on April 1, 2003, the priority of which is claimed in the above-identified application.

Respectfully submitted,

CHRISTIE, PARKER & HALE, LLP

By D Bruce Prout
D. Bruce Prout
Reg. No. 20,958
626/795-9900

DBP/aam
Enclosure: Certified copy of patent application

AAM PAS539561.1-*-12/4/03 10:15 AM



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출원 번호 : 10-2003-0020432
Application Number

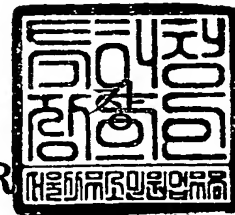
출원 년 월 일 : 2003년 04월 01일
Date of Application APR 01, 2003

출원인 : 삼성에스디아이 주식회사
Applicant(s) SAMSUNG SDI CO., LTD.



2003 년 09 월 03 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 특허출원서
【권리구분】 특허
【수신처】 특허청장
【참조번호】 0002
【제출일자】 2003.04.01
【발명의 명칭】 발광 표시 장치 및 그 표시 패널과 구동 방법
【발명의 영문명칭】 LIGHT EMITTING DISPLAY DEVICE AND DISPLAY PANEL AND DRIVING METHOD THEREOF

【출원인】

【명칭】 삼성에스디아이 주식회사

【출원인코드】 1-1998-001805-8

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인코드】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 이원일

【포괄위임등록번호】 2001-041982-6

【발명자】

【성명의 국문표기】 권오경

【성명의 영문표기】 KWON, OH KYONG

【주민등록번호】 550407-1023118

【우편번호】 138-240

【주소】 서울특별시 송파구 신천동 장미아파트 14동 1102호

【국적】 KR

【심사청구】 청구

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사를 청구합니다. 대리인 유미특허법인 (인)

【수수료】

【기본출원료】 20 면 29,000 원

【가산출원료】 33 면 33,000 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 40 항 1,389,000 원

【합계】 1,451,000 원

1020030020432

출력 일자: 2003/9/8

【첨부서류】

1. 요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】**【요약】**

유기 전계발광 표시 장치의 화소 회로에 트랜지스터와 제1 내지 제3 스위칭 소자가 형성되어 있다. 트랜지스터는 유기 전계발광 소자를 발광시키기 위한 구동 전류를 공급하며 제1 및 제2 주 전극과 제어 전극을 가진다. 제1 스위칭 소자는 제1 제어 신호에 응답하여 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키며, 제1 저장 소자는 제2 제어 신호에 응답하여 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압을 저장한다. 제2 스위칭 소자는 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 데이터선으로부터의 데이터 신호를 전달하며, 제2 저장 소자는 제1 스위칭 소자로부터의 데이터 전류에 대응하는 제2 전압을 저장한다. 제3 스위칭 소자는 제3 제어 신호에 응답하여 트랜지스터로부터의 구동 전류를 유기 전계발광 소자로 전달한다. 그리고 제1 및 제2 전압을 각각 저장하고 있는 제1 및 제2 저장 소자의 커패시턴스에 의해 결정된 제3 전압이 제1 트랜지스터에 인가되어 구동 전류가 유기 전계발광 소자에 공급된다.

【대표도】

도 5

【색인어】

유기 EL, 커패시터, 트랜지스터, 커패시턴스, 문턱 전압, 전류 구동

【명세서】

【발명의 명칭】

발광 표시 장치 및 그 표시 패널과 구동 방법 {LIGHT EMITTING DISPLAY
DEVICE AND DISPLAY PANEL AND DRIVING METHOD THEREOF}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 유기 전계발광 소자의 개념도이다.

도 2는 종래의 전압 기입 방식의 화소 회로의 등가 회로도이다.

도 3은 종래의 전류 기입 방식의 화소 회로의 등가 회로도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치의 개략적인
평면도이다.

도 5, 도 7, 도 9, 도 11, 도 13, 도 14 및 도 15는 각각 본 발명의 제1 내
지 제7 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이다.

도 6, 도 8, 도 10, 도 12 및 도 16은 각각 도 5, 도 7, 도 9, 도 11 및 도
15의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형도이다.

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<7> 본 발명은 발광 표시 장치와 그 표시 패널 및 그 구동 방법에 관한 것으로,
특히 유기 전계발광(electroluminescent, 이하 EL이라 함) 표시 장치에 관한 것
이다.

<8> 일반적으로 유기 EL 표시 장치는 형광성 유기 화합물을 전기적으로 여기시켜 발광시키는 표시 장치로서, N개의 유기 발광셀들을 전압 구동 혹은 전류 구동하여 영상을 표현할 수 있도록 되어 있다. 이러한 유기 발광셀은 도 1에 나타난 바와 같이 애노드(ITO), 유기 박막, 캐소드 레이어(metal)의 구조를 가지고 있다. 유기 박막은 전자와 정공의 균형을 좋게 하여 발광 효율을 향상시키기 위해 발광층(emitting layer, EML), 전자 수송층(electron transport layer, ETL) 및 정공 수송층(hole transport layer, HTL)을 포함한 다층 구조로 이루어지고, 또한 별도의 전자 주입층(electron injecting layer, EIL)과 정공 주입층(hole injecting layer, HIL)을 포함하고 있다.

<9> 이와 같이 이루어지는 유기 발광셀을 구동하는 방식에는 단순 매트릭스(passive matrix) 방식과 박막 트랜지스터(thin film transistor, TFT) 또는 MOSFET를 이용한 능동 구동(active matrix) 방식이 있다. 단순 매트릭스 방식은 양극과 음극을 직교하도록 형성하고 라인을 선택하여 구동하는데 비해, 능동 구동 방식은 박막 트랜지스터와 커패시터를 각 ITO(indium tin oxide) 화소 전극에 접속하여 커패시터 용량에 의해 전압을 유지하도록 하는 구동 방식이다. 이때, 커패시터에 전압을 유지시키기 위해 인가되는 신호의 형태에 따라 능동 구동 방식은 전압 기입(voltage programming) 방식과 전류 기입(current programming) 방식으로 나뉘어진다.

<10> 아래에서는 도 2 및 도 3을 참조하여 종래 기술에 따른 전압 및 전류 기입 방식의 유기 EL 표시 장치에 대하여 설명한다.

<11> 도 2는 유기 EL 소자를 구동하기 위한 종래의 전압 기입 방식의 화소 회로로서, N개의 화소 중 하나를 대표적으로 도시한 것이다. 도 2를 참조하면, 유기 EL 소자(OLED)에 트랜지스터(M1)가 연결되어 발광을 위한 전류를 공급한다. 트랜지스터(M1)의 전류량은 스위칭 트랜지스터(M2)를 통해 인가되는 데이터 전압에 의해 제어되도록 되어 있다. 이때, 인가된 전압을 일정 기간 유지하기 위한 커패시터(C1)가 트랜지스터(M1)의 소스와 게이트 사이에 연결되어 있다. 트랜지스터(M2)의 게이트에는 주사선(S_n)이 연결되어 있으며, 소스 측에는 데이터선(D_m)이 연결되어 있다.

<12> 이와 같은 구조의 화소의 동작을 살펴보면, 스위칭 트랜지스터(M2)의 게이트에 인가되는 선택 신호에 의해 트랜지스터(M2)가 턴온 되면, 데이터선(D_m)으로부터의 데이터 전압이 트랜지스터(M1)의 게이트에 인가된다. 그러면 커패시터(C1)에 의해 게이트와 소스 사이에 충전된 전압(V_{GS})에 대응하여 트랜지스터(M2)에 전류(I_{OLED})가 흐르고, 이 전류(I_{OLED})에 대응하여 유기 EL 소자(OLED)가 발광한다.

<13> 이때, 유기 EL 소자(OLED)에 흐르는 전류는 다음의 수학식 1과 같다.

<14> **【수학식 1】**
$$I_{OELD} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 = \frac{\beta}{2} (V_{DD} - V_{DATA} - |V_{TH}|)^2$$

<15> 여기서, I_{OLED}는 유기 EL 소자(OLED)에 흐르는 전류, V_{GS}는 트랜지스터(M1)의 소스와 게이트 사이의 전압, V_{TH}는 트랜지스터(M1)의 문턱 전압, V_{DATA}는 데이터 전압, β는 상수 값을 나타낸다.

- <16> 수학식 1에 나타낸 바와 같이, 도 2에 도시한 화소 회로에 의하면 인가되는 데이터 전압에 대응하는 전류가 유기 EL 소자(OELD)에 공급되고, 공급된 전류에 대응하여 유기 EL 소자가 발광하게 된다. 이때, 인가되는 데이터 전압은 계조를 표현하기 위하여 일정 범위에서 다단계의 값을 갖는다.
- <17> 그런데 이와 같은 종래의 전압 기입 방식의 화소 회로에서는 제조 공정의 불균일성에 의해 생기는 박막 트랜지스터의 문턱 전압(V_{TH}) 및 전자 이동도 (electron mobility)의 편차로 인해 고계조를 얻기 어렵다는 문제점이 있다. 예를 들어, 3V로 화소의 박막 트랜지스터를 구동하는 경우 8비트(256) 계조를 표현하기 위해서는 $12mV(=3V/256)$ 간격으로 박막 트랜지스터의 게이트에 전압을 인가해야 하는데, 만일 제조 공정의 분균일로 인한 박막 트랜지스터의 문턱 전압의 편차가 100mV인 경우에는 고계조를 표현하기 어려워진다. 또한 이동도의 편차로 인해 수학식 1에서의 β 값이 달라지므로 더욱 고계조를 표현하기 어렵게 된다.
- <18> 이에 반해 전류 기입 방식의 화소 회로는 화소 회로에 전류를 공급하는 전류원이 패널 전체를 통해 균일하다고 하면 각 화소내의 구동 트랜지스터가 불균일한 전압-전류 특성을 갖는다 하더라도 균일한 디스플레이 특성을 얻을 수 있다.
- <19> 도 3은 유기 EL 소자를 구동하기 위한 종래의 전류 기입 방식의 화소 회로로서, N개의 화소 중 하나를 대표적으로 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 유기EL 소자(OLED)에 트랜지스터(M1)가 연결되어 발광을 위한 전류를 공급하며, 트랜지스터(M1)의 전류량은 트랜지스터(M2)를 통해 인가되는 데이터 전류에 의해 제어되도록 되어있다.

<20> 먼저, 주사선(S_n)으로부터의 선택 신호에 의해 트랜지스터(M2, M3)가 턴온 되면, 트랜지스터(M1)는 다이오드 연결 상태가 되고 데이터선(D_m)으로부터의 데이터 전류(I_{DATA})에 대응하는 전압이 커패시터(C1)에 저장된다. 다음, 주사선(S_n)으로부터의 선택 신호가 하이 레벨이 되어 트랜지스터(M2, M3)가 턴오프되고, 주사선(E_n)으로부터의 발광 신호가 로우 레벨이 되어 트랜지스터(M4)가 턴온된다. 그러면 전원 전압(VDD)으로부터 전원이 공급되고 커패시터(C1)에 저장된 전압에 대응하는 전류가 유기 EL 소자(OLED)로 흘러 발광이 이루어진다. 이때, 유기 EL 소자(OLED)에 흐르는 전류는 수학적 식 2와 같다.

<21> **【수학적 식 2】**
$$I_{OLED} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 = I_{DATA}$$

<22> 여기서, V_{GS} 는 트랜지스터(M1)의 소스와 게이트 사이의 전압, V_{TH} 는 트랜지스터(M1)의 문턱전압, β 는 상수 값을 나타낸다.

<23> 수학적 식 2에서 나타낸 바와 같이 종래의 전류 픽셀회로에 의하면, 유기 EL 소자에 흐르는 전류(I_{OLED})는 데이터 전류(I_{DATA})와 동일하므로 기입 전류원이 패널 전체를 통해 균일하다고 하면 균일한 특성을 얻을 수 있게 된다. 그런데 유기 EL 소자에 흐르는 전류(I_{OLED})는 미세 전류이므로, 미세 전류(I_{DATA})로서 화소 회로를 제어해야 하므로 데이터선을 충전하는데 시간이 많이 걸린다는 문제점이 있다. 예를 들어, 데이터선 부하 커패시턴스가 30pF이라 가정할 경우에 수십nA에서 수백nA 정도의 데이터 전류로 데이터선의 부하를 충전하려면 수ms의 시간이 필요하다. 이는 수십 μ s 수준인 라인 시간(line time)을 고려 해볼 때 충전 시간이 충분하지 못하다는 문제점이 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<24> 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 트랜지스터의 문턱 전압이나 이동도를 보상할 수 있으며 데이터선을 충분히 충전시킬 수 있는 발광 표시 장치를 제공하는 것이다.

【발명의 구성 및 작용】

<25> 본 발명의 첫 번째 특징에 따른 발광 표시 장치는 표시 패널을 포함하며, 표시 패널에는 화상 신호를 나타내는 데이터 전류를 전달하는 복수의 데이터선, 선택 신호를 전달하는 복수의 주사선, 그리고 데이터선과 주사선에 의해 정의되는 복수의 화소에 각각 형성되는 복수의 화소 회로가 형성되어 있다. 화소 회로는, 발광 소자, 제1 트랜지스터, 제1 내지 제3 스위칭 소자, 제1 및 제2 저장 소자를 포함한다. 발광 소자는 인가되는 전류에 대응하여 빛을 발광하며, 제1 트랜지스터는 발광 소자를 발광시키기 위한 구동 전류를 공급하며 제1 및 제2 주전극과 제어 전극을 가진다. 제1 스위칭 소자는 제1 제어 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키며, 제1 저장 소자는 제2 제어 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압을 저장한다. 제2 스위칭 소자는 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 데이터선으로부터의 데이터 신호를 전달하며, 제2 저장 소자는 상기 제1 스위칭 소자로부터의 데이터 전류에 대응하는 제2 전압을 저장한다. 제3 스위칭 소자는 제3 제어 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터로부터의 구동 전류를 발광 소자로 전달한다. 상기 제1 및 제2 전압을 각각 저장하고 있는 제1 및 제2 저장 소자의 커플링에 의해

결정된 제3 전압이 상기 제1 트랜지스터에 인가되어 상기 구동 전류가 발광 소자에 공급된다.

<26> 이때, 제2 제어 신호, 선택 신호 및 제3 제어 신호 순으로 인에이블되는 것이 바람직하다.

<27> 상기 화소 회로는 제2 제어 신호에 응답하여 턴온되며 제1단이 제1 트랜지스터의 제어 전극에 연결되는 제4 스위칭 소자를 더 포함하는 것이 바람직하다. 제2 저장 소자는 제1 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 연결되는 제1 커패시터에 의해 형성되며, 제1 저장 소자는 제1 트랜지스터의 제1 주 전극과 제4 스위칭 소자의 제2단 사이에 연결되는 제2 커패시터와 제1 커패시터의 병렬 연결에 의해 형성된다.

<28> 제2 제어 신호는 상기 주사선으로부터의 상기 선택 신호일 수 있다. 이때, 제4 스위칭 소자는 상기 선택 신호의 디스에이블 구간에서 응답한다.

<29> 그리고 제1 제어 신호는 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 현재 주사선으로부터의 선택 신호로 이루어질 수 있다. 이때, 상기 제1 스위칭 소자는, 이전 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키는 제2 트랜지스터 및 현재 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키는 제3 트랜지스터를 포함한다.

<30> 또한, 제2 제어 신호는 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호로 이루어질 수 있다. 이때, 화소 회로는 상기 제4 스위칭 소자에 병렬로

연결되는 제5 스위칭 소자를 더 포함하며, 제4 및 제5 스위칭 소자는 각각 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 제3 제어 신호에 응답하여 턴온된다.

<31> 본 발명의 두 번째 특징에 따른 발광 표시 장치의 표시 패널은 복수의 화소 회로를 포함한다. 화소 회로는, 제1 트랜지스터, 제1 내지 제4 스위칭 소자, 발광 소자, 제1 및 제2 저장 소자를 포함한다. 제1 트랜지스터는 제1 전압을 공급하는 제1 전원에 제1 주 전극이 연결되며, 제1 스위칭 소자는 제1 트랜지스터의 제2 주 전극과 데이터선에 사이에 연결되며 주사선으로부터의 제1 선택 신호에 의해 제어된다. 제2 스위칭 소자는 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시킴으로써 제1 제어 신호에 의해 제어되며, 제3 스위칭 소자는 제1 트랜지스터의 제어 전극에 제1단이 연결되며 제2 제어 신호에 의해 제어된다. 제4 스위칭 소자는 제1 트랜지스터의 제2 주 전극에 제1단이 연결되며 제3 제어 신호에 의해 제어되며, 발광 소자는 인가되는 전류에 대응하여 빛을 발광하며 제4 스위칭 소자의 제2단과 제2 전압을 공급하는 제2 전원 사이에 연결된다. 제1 저장 소자는 제3 스위칭 소자가 온 상태일 때 제1 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 연결되며, 제2 저장 소자는 제3 스위칭 소자가 오프 상태일 때 제1 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 연결된다.

<32> 본 발명의 세 번째 및 네 번째 특징에 따르면, 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 데이터선으로부터의 데이터 전류를 전달하는 스위칭 소자, 데이터 전류에 대응하여 구동 전류를 출력하며 제1 및 제2 주 전극과 제어 전극을 가지는 트랜지스터, 그리고 상기 트랜지스터로부터의 구동 전류에 대응하여 빛을 발

광하는 발광 소자를 포함하는 화소 회로가 형성되어 있는 발광 표시 장치를 구동하는 방법이 제공된다.

<33> 본 발명의 세 번째 특징에 따른 구동 방법에 의하면, 먼저 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 형성되는 제1 저장 소자에 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압을 저장한다. 그리고 스위칭 소자로부터의 데이터 전류에 대응하는 제2 전압이 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 형성되는 제2 저장 소자에 저장된다. 다음, 제1 및 제2 저장 소자를 커플링하여 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이의 전압을 제3 전압으로 하고, 트랜지스터로부터의 구동 전류를 발광 소자로 전달한다. 이때, 트랜지스터로부터의 구동 전류는 제3 전압에 대응하여 결정된다.

<34> 본 발명의 네 번째 특징에 따른 구동 방법에 의하면, 먼저 제1 제어 신호에 응답하여 상기 트랜지스터가 다이오드 형태로 연결되며, 제2 제어 신호의 제1 레벨에 응답하여 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 제1 저장 소자가 연결되어 상기 제1 저장 소자에 상기 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압이 저장된다. 그리고 제2 제어 신호의 제2 레벨에 응답하여 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 제2 저장 소자가 연결되고, 주사선으로부터의 제1 선택 신호에 응답하여 상기 제2 저장 소자에 데이터 전류에 대응하는 제2 전압이 저장된다. 다음, 제2 제어 신호의 제1 레벨에 응답하여 상기 제1 및 제2 저장 소자가 커플링되어 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이의 전압이 제3 전압으로 되며, 상기 트랜지스터에는 제3 전압에 대응하는 구동 전류가 흐르고, 제3 제어 신호에 응답하여 구동 전류가 발광 소자로 공급된다.

<35> 본 발명의 다섯 번째 특징에 따르면, 제1 선택 신호에 응답하여 화상 신호를 나타내는 데이터 전류를 트랜지스터로 전달하여 발광 소자를 구동하는 방법이 제공된다. 먼저, 제1 및 제2 스위칭 소자에 각각 인가되는 제1 및 제2 제어 신호를 인에이블 레벨로 하여 상기 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압을 저장하고, 제3 스위칭 소자에 인가되는 제3 제어 신호를 디스에이블 레벨로 하여 상기 트랜지스터와 발광 소자를 전기적으로 차단하고, 제4 스위칭 소자에 인가되는 제1 선택 신호를 디스에이블 레벨로 하여 데이터 전류를 차단한다. 그리고 제1 선택 신호를 인에이블 레벨로 하여 데이터 전류를 공급하고, 제1 및 제2 제어 신호를 각각 인에이블 및 디스에이블 레벨로 하여 데이터 전류에 대응하는 제2 전압을 저장한다. 다음, 제1 선택 신호를 디스에이블 레벨로 하여 데이터 전류를 차단하고, 제1 및 제2 제어 신호를 각각 디스에이블 및 인에이블로 하여 제3 전압을 상기 트랜지스터의 주 전극과 게이트 전극에 인가하고, 제3 제어 신호를 인에이블로 하여 상기 트랜지스터로부터의 전류를 발광 소자로 전달한다. 이때, 제3 전압은 제1 및 제2 전압에 의해 결정된다.

<36> 아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

<37> 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연

결되어 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 전기적으로 연결되어 있는 경우도 포함한다.

<38> 이제 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치 및 그 화소 회로와 구동 방법에 대하여 도면을 참고로 하여 상세하게 설명한다.

<39> 먼저, 도 4를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치에 대하여 자세하게 설명한다. 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치의 개략적인 평면도이다.

<40> 도 4에 나타난 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치는 유기 EL 표시 패널(10), 주사 구동부(20) 및 데이터 구동부(30)를 포함한다.

<41> 유기 EL 표시 패널(10)은 행 방향으로 뻗어 있는 복수의 데이터선(D_1-D_N), 열 방향으로 뻗어 있는 복수의 주사선(S_1-S_M , E_1-E_M , X_1-X_M , Y_1-Y_M) 및 복수의 화소 회로(11)를 포함한다. 데이터선(D_1-D_N)은 화상 신호를 나타내는 데이터 신호를 화소 회로(11)로 전달하며, 주사선(S_1-S_M)은 선택 신호를 화소 회로(11)로 전달한다. 화소 회로(11)는 이웃한 두 데이터선(D_1-D_N)과 이웃한 두 주사선(S_1-S_M)에 의해 정의되는 화소 영역에 형성되어 있다. 또한 주사선(E_1-E_M)은 화소 회로(11)의 발광을 제어하는 발광 신호를 전달하며, 주사선(X_1-X_M , Y_1-Y_M)은 각각 화소 회로(11)의 동작을 제어하기 위한 제어 신호를 전달한다.

<42> 주사 구동부(20)는 주사선(S_1-S_M , E_1-E_M)에 각각 선택 신호와 발광 신호를 순차적으로 인가하며, 또한 주사선(X_1-X_M , Y_1-Y_M)에 제어 신호를 순차적으로 인

가한다. 데이터 구동부(30)는 데이터선(D_1 - D_N)에 화상 신호를 나타내는 데이터 전류를 인가한다.

<43> 주사 구동부(20) 및/또는 데이터 구동부(30)는 표시 패널(10)에 전기적으로 연결될 수 있으며 또는 표시 패널(10)에 접착되어 전기적으로 연결되어 있는 테이프 캐리어 패키지(tape carrier package, TCP)에 칩 등의 형태로 장착될 수 있다. 또는 표시 패널(10)에 접착되어 전기적으로 연결되어 있는 가요성 인쇄 회로(flexible printed circuit, FPC) 또는 필름(film) 등에 칩 등의 형태로 장착될 수도 있으며, 이를 CoF(chip on flexible board, chip on film) 방식이라 한다. 이와는 달리 주사 구동부(20) 및/또는 데이터 구동부(30)는 표시 패널의 유리 기판 위에 직접 장착될 수도 있으며, 또는 유리 기판 위에 주사선, 데이터선 및 박막 트랜지스터와 동일한 층들로 형성되어 있는 구동 회로와 대체될 수도 직접 장착될 수도 있다. 이를 CoG(chip on glass) 방식이라 한다.

<44> 아래에서는 도 5 및 도 6을 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 EL 표시 장치의 화소 회로(11)에 대하여 상세하게 설명한다. 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이며, 도 6은 도 5의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형도이다. 그리고 도 5에서는 설명의 편의상 m번째 데이터선(D_m)과 n번째 주사선(S_n)에 연결된 화소 회로만을 도시하였다.

<45> 도 5에 나타난 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 화소 회로(11)는 유기 EL 소자(OLED), 트랜지스터(M1-M5) 및 커패시터(C1, C2)를 포함하며, 트랜지스터(M1-M5)는 PMOS 트랜지스터로 형성되어 있다. 이러한 트랜지스터는 표시 패널(10)의 유리 기판 위에 형성되는 게이트 전극, 드레인 전극 및 소스 전극을

각각 제어 전극 및 2개의 주(main) 전극으로 가지는 박막 트랜지스터인 것이 바람직하다.

<46> 트랜지스터(M1)는 전원 전압(VDD)에 소스가 연결되고 트랜지스터(M5)에 게이트가 연결되어 있으며, 트랜지스터(M1)의 게이트와 드레인 사이에는 트랜지스터(M3)가 연결되어 있다. 트랜지스터(M1)는 게이트와 소스 사이에 걸리는 전압(V_{GS})에 대응하는 전류(I_{OLED})를 출력한다. 트랜지스터(M3)는 주사선(X_n)으로부터의 제어 신호($CS1_n$)에 응답하여 트랜지스터(M1)를 다이오드 형태로 연결시킨다. 커패시터(C1)는 전원 전압(VDD)과 트랜지스터(M1)의 게이트 사이에 연결되며, 커패시터(C2)는 전원 전압(VDD)과 트랜지스터(M5)의 제1단 사이에 연결된다. 이러한 커패시터(C1, C2)는 트랜지스터의 게이트와 소스 사이의 전압을 저장하는 저장 소자로서 작용한다. 트랜지스터(M5)의 제2단은 트랜지스터(M1)의 게이트에 연결되며, 트랜지스터(M5)는 주사선(Y_n)으로부터의 제어 신호($CS2_n$)에 응답하여 커패시터(C1, C2)를 커플링시킨다.

<47> 트랜지스터(M2)는 주사선(S_n)으로부터의 선택 신호(SE_n)에 응답하여 데이터선(D_m)으로부터의 데이터 전류(I_{DATA})를 트랜지스터(M1)로 전달한다. 트랜지스터(M4)는 트랜지스터(M1)의 드레인과 유기 EL 소자(OLED) 사이에 연결되어, 주사선(E_n)으로부터의 발광 신호(EM_n)에 응답하여 트랜지스터(M1)의 전류(I_{OLED})를 유기 EL 소자(OLED)로 전달한다. 유기 EL 소자(OLED)는 트랜지스터(M4)와 기준 전압 사이에 연결되며 인가되는 전류(I_{OLED})의 양에 대응하는 빛을 발광한다.

- <48> 다음, 도 6을 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 화소 회로의 동작에 대하여 상세하게 설명한다.
- <49> 도 6을 보면, 먼저 구간(T1)에서는 로우 레벨의 제어 신호($CS2_n$)에 의해 트랜지스터(M5)가 턴온되어 커패시터(C1, C2)는 트랜지스터(M1)의 게이트와 소스 사이에서 병렬 연결된다. 그리고 로우 레벨의 제어 신호($CS1_n$)에 의해 트랜지스터(M3)가 턴온되어 트랜지스터(M1)는 다이오드 형태로 연결되며, 다이오드 형태로 연결된 트랜지스터(M1)에 의해 병렬 연결된 커패시터(C1, C2)에는 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(V_{TH})이 저장된다. 또한 하이 레벨의 발광 신호(EM_n)에 의해 트랜지스터(M4)가 턴오프되어 유기 EL 소자(OLED)로의 전류가 차단되어 있다. 즉, 구간(T1)에서는 커패시터(C1, C2)에 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(V_{TH})이 샘플링된다.
- <50> 구간(T2)에서는 제어 신호($CS2_n$)가 하이 레벨로 되어 트랜지스터(M5)가 턴오프되고, 선택 신호(SE_n)가 로우 레벨로 되어 트랜지스터(M2)가 턴온된다. 턴오프된 트랜지스터(M5)에 의해 커패시터(C2)는 전압이 충전된 상태에서 플로팅된다. 그리고 턴온된 트랜지스터(M2)에 의해 데이터선(D_m)으로부터의 데이터 전류(I_{DATA})가 트랜지스터(M1)에 흐르게 된다. 그러면 데이터 전류(I_{DATA})에 대응하여 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압($V_{GS}(T2)$)이 결정되고, 게이트-소스 전압($V_{GS}(T2)$)이 커패시터(C1)에 저장된다. 트랜지스터(M1)에는 데이터 전류(I_{DATA})가 흐르므로 데이터 전류(I_{DATA})는 수학적 식 3과 같이 나타낼 수 있으며, 수학적 식 3으로부터 구간(T2)에서의 게이트-소스 전압($V_{GS}(T2)$)은 수학적 식 4로 주

어진다. 즉, 구간(T2)에서는 데이터 전류(I_{DATA})에 해당하는 게이트-소스 전압이 화소 회로의 커패시터(C1)에 기입된다.

<51> **【수학식 3】**
$$I_{DATA} = \frac{\beta}{2} (|V_{GS}(T2)| - |V_{TH}|)^2$$

<52> **【수학식 4】**
$$|V_{GS}(T2)| = \sqrt{\frac{2I_{DATA}}{\beta}} + |V_{TH}|$$

<53> 여기서, β 는 상수값이다.

<54> 다음, 구간(T3)에서는 하이 레벨의 제어 신호($CS1_n$) 및 선택 신호(SE_n)에 응답하여 트랜지스터(M3, M2)가 턴오프되고, 로우 레벨의 제어 신호($CS2_n$) 및 발광 신호(EM_n)에 의해 트랜지스터(M5, M4)가 턴온된다. 트랜지스터(M5)가 턴온되면 커패시터(C1, C2)의 커플링에 의해 구간(T3)에서의 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압($V_{GS}(T3)$)은 수학식 5와 같이 된다.

<55> **【수학식 5】**
$$|V_{GS}(T3)| = |V_{TH}| + \frac{C_1}{C_1 + C_2} (|V_{GS}(T2)| - |V_{TH}|)$$

<56> 여기서, C_1 및 C_2 는 각각 커패시터(C1, C2)의 커패시턴스이다.

<57> 따라서 트랜지스터(M1)에 흐르는 전류(I_{OLED})는 수학식 6과 같이 되며, 이 전류(I_{OLED})가 턴온된 트랜지스터(M4)에 의해 유기 EL 소자(OLED)에 공급되어 발광이 이루어진다. 즉, 구간(T3)에서는 커패시터(C1, C2)의 커플링에 의해 전압이 분배되고 유기 EL 소자(OLED)의 발광이 이루어진다.

<58> **【수학식 6】**
$$I_{OLED} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} (|V_{GS}(T2)| - |V_{TH}|) \right)^2 = \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} \right)^2 I_{DATA}$$

<59> 수학적 식 6에 나타난 바와 같이, 유기 EL 소자(OLED)에 공급되는 전류(I_{OLED})는 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(V_{TH})이나 이동도에 관계없이 결정되므로, 문턱 전압의 편차나 이동도의 편차가 보상될 수 있다. 또한 유기 EL 소자(OLED)에 공급되는 전류(I_{OLED})는 데이터 전류(I_{DATA})에 비해 $C_1/(C_1+C_2)$ 의 제곱 배만큼 작은 값이다. 예를 들어 C_2 가 C_1 의 M배($C_2=M*C_1$)라면, 전류(I_{OLED})에 대해 $(M+1)^2$ 배만큼 큰 데이터 전류(I_{DATA})로서 유기 EL 소자(OLED)에 흐르는 미세 전류를 제어할 수 있으므로, 고계조를 표현할 수 있다. 그리고 데이터선(D_1-D_m)에 큰 데이터 전류(I_{DATA})를 공급하므로 데이터선의 충전 시간을 충분히 확보할 수 있다.

<60> 본 발명의 제1 실시예에서는 트랜지스터(M1-M5)를 PMOS 트랜지스터로 구현하였지만, 이를 NMOS 트랜지스터로 구현할 수 있다. 아래에서는 이러한 실시예에 대하여 도 7 및 도 8을 참조하여 설명한다.

<61> 도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이며, 도 8은 도 7의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형도이다.

<62> 도 7에 나타난 화소 회로에서는 트랜지스터(M1-M5)가 NMOS 트랜지스터로 형성되어 있으며, 그 연결 구조는 도 5의 화소 회로와 대칭을 이룬다. 자세하게 설명하면, 트랜지스터(M1)는 기준 전압에 소스가 연결되고 트랜지스터(M5)에 게이트가 연결되어 있으며, 트랜지스터(M1)의 게이트와 드레인 사이에는 트랜지스터(M3)가 연결되어 있다. 커패시터(C_1)는 기준 전압과 트랜지스터(M1)의 게이트 사이에 연결되며, 커패시터(C_2)는 기준 전압과 트랜지스터(M5)의 제1단 사이에 연결된다. 트랜지스터(M5)의 제2단은 트랜지스터(M1)의 게이트에 연결되며, 트

랜지스터(M3, M5)의 게이트에는 각각 주사선(X_n , Y_n)으로부터의 제어 신호($CS1_n$, $CS2_n$)가 인가된다. 트랜지스터(M2)는 주사선(S_n)으로부터의 선택 신호(SE_n)에 응답하여 데이터선(D_m)으로부터의 데이터 전류(I_{DATA})를 트랜지스터(M1)로 전달한다. 트랜지스터(M4)는 트랜지스터(M1)의 드레인과 유기 EL 소자(OLED) 사이에 연결되며, 그 게이트에 주사선(E_n)으로부터의 발광 신호(EM_n)가 인가된다. 유기 EL 소자(OLED)는 트랜지스터(M4)와 전원 전압(VDD) 사이에 연결된다.

<63> 도 7의 화소 회로는 NMOS 트랜지스터로 형성되어 있으므로, 도 8에 나타낸 바와 같이 도 7의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형은 도 6의 구동 파형에 대해 반전된 형태를 가진다. 본 발명의 제2 실시예에 따른 화소 회로의 자세한 동작은 도 7 및 도 8과 제1 실시예의 설명으로부터 용이하게 알 수 있으므로 자세한 설명을 생략한다.

<64> 본 발명의 제1 및 제2 실시예에 의하면, 트랜지스터(M1-M5)가 모두 동일 타입의 트랜지스터이므로 표시 패널(10)의 유리 기판 위에 박막 트랜지스터를 형성하는 공정을 간단하게 할 수 있다.

<65> 본 발명의 제1 및 제2 실시예에서는 트랜지스터(M1-M5)를 PMOS 또는 NMOS 트랜지스터로 구현하였지만, 이에 한정되지 않고 PMOS와 NMOS의 조합, 또는 유사한 기능을 하는 다른 스위칭 소자로 구현할 수 있다.

<66> 그리고 본 발명의 제1 및 제2 실시예에서는 두 개의 제어 신호($CS1_n$, $CS2_n$)를 사용하여 화소 회로를 제어하였지만, 하나의 제어 신호만을 사용하여 화소 회로를 제어할 수 있다. 아래에서는 이러한 실시예에 대하여 도 9 내지 도 12를 참조하여 상세하게 설명한다.

- <67> 도 9는 본 발명의 제3 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이며, 도 10은 도 9의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형도이다.
- <68> 도 9에 나타난 바와 같이, 본 발명의 제3 실시예에 따른 화소 회로는 트랜지스터(M2, M5)를 제외하면 제1 실시예와 동일한 구조를 가진다. 트랜지스터(M2)는 NMOS 트랜지스터로 형성되어 있으며, 트랜지스터(M2, M5)의 게이트는 주사선(S_n)에 공통으로 연결되어 있다. 즉, 트랜지스터(M5)는 주사선(S_n)으로부터의 선택 신호(SE_n)에 의해 구동된다.
- <69> 도 10을 보면, 구간(T1)에서는 로우 레벨의 제어 신호($CS1_n$) 및 선택 신호(SE_n)에 의해 트랜지스터(M3, M5)가 턴온된다. 턴온된 트랜지스터(M3)에 의해 트랜지스터(M1)는 다이오드 형태로 연결되어, 커패시터(C1, C2)에는 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(V_{TH})이 저장된다. 또한 하이 레벨의 발광 신호(EM_n)에 의해 트랜지스터(M4)가 턴오프되어 유기 EL 소자(OLED)로의 전류가 차단되어 있다.
- <70> 구간(T2)에서는 선택 신호(SE_n)가 하이 레벨로 되어 트랜지스터(M2)가 턴온되고 트랜지스터(M5)가 턴오프된다. 그러면 커패시터(C1)에는 수학식 4에 나타난 전압($V_{GS}(T2)$)이 충전된다. 이때, 선택 신호(SE_n)에 의해 트랜지스터(M2)가 턴온되는 순간 커패시터(C2)에 충전된 전압이 바뀔 수 있으므로, 이를 방지하기 위해 트랜지스터(M2)가 턴온되기 전에 트랜지스터(M3)를 턴오프시킨 후 트랜지스터(M2)가 턴온된 후에 다시 트랜지스터(M3)를 턴온시킨다. 즉, 선택 신호(SE_n)가 하이 레벨로 되기 전에 제어 신호($CS1_n$)를 잠깐동안 하이 레벨로 반전시킨다.

- <71> 본 발명의 제3 실시예에서의 나머지 동작은 제1 실시예와 동일하므로 자세한 설명은 생략한다. 이러한 제3 실시예에 의하면, 제어 신호($CS2_n$)를 공급하는 주사선(Y_1-Y_N)을 없앨 수 있으므로 화소의 개구율을 높일 수 있다.
- <72> 그리고 본 발명의 제3 실시예에서는 트랜지스터(M1, M3-M5)를 PMOS 트랜지스터로 구현하고 트랜지스터(M2)를 NMOS 트랜지스터로 구현하였지만, 이와는 반대로 구현할 수도 있다. 아래에서는 이러한 실시예에 대하여 도 11 및 도 12를 참조하여 설명한다.
- <73> 도 11은 본 발명의 제4 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이며, 도 12는 도 11의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형도이다.
- <74> 도 11에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제4 실시예에 따른 화소 회로는 트랜지스터(M2)가 PMOS 트랜지스터로 구현되고 트랜지스터(M1, M3-M5)가 NMOS 트랜지스터로 구현되어 있으며, 그 연결 구조는 도 9의 화소 회로와 대칭을 이룬다. 또한 도 12에 나타낸 바와 같이 도 11의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형은 도 10의 구동 파형에 대해 반전된 형태를 가진다. 제4 실시예에 따른 화소 회로의 연결 구조 및 동작에 대해서는 제3 실시예의 설명으로부터 용이하게 알 수 있으므로 자세한 설명을 생략한다.
- <75> 본 발명의 제1 내지 제4 실시예에서는 커패시터(C1, C2)를 전원 전압(VDD)에 병렬로 연결하였지만, 이와는 달리 커패시터(C1, C2)를 전원 전압(VDD)에 직렬로 연결할 수도 있다. 아래에서는 이러한 실시예에 대하여 도 13 및 도 14를 참조하여 상세하게 설명한다.

- <76> 도 13은 본 발명의 제5 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이다.
- <77> 도 13에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제5 실시예에 따른 화소 회로는 커패시터(C1, C2) 및 트랜지스터(M5)의 연결 상태를 제외하면 제1 실시예와 동일한 구조를 가진다. 자세하게 설명하면, 커패시터(C1, C2)는 전원 전압(VDD)과 트랜지스터(M3) 사이에 직렬로 연결되며, 트랜지스터(M5)는 커패시터(C1, C2)의 접점과 트랜지스터(M1)의 게이트 사이에 연결되어 있다.
- <78> 제5 실시예에 따른 화소 회로는 제1 실시예와 동일한 구동 파형에 의해 구동되며, 자세한 동작에 대하여 도 6 및 도 13을 참조하여 설명한다.
- <79> 먼저, 구간(T1)에서는 로우 레벨의 제어 신호($CS1_n$)에 의해 트랜지스터(M3)가 턴온되어 트랜지스터(M1)는 다이오드 형태로 연결된다. 다이오드 형태로 연결된 트랜지스터(M1)에 의해 커패시터(C1)에는 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(V_{TH})이 저장되고, 커패시터(C2)의 전압은 0V로 된다. 또한 하이 레벨의 발광 신호(EM_n)에 의해 트랜지스터(M4)가 턴오프되어 유기 EL 소자(OLED)로의 전류가 차단되어 있다.
- <80> 구간(T2)에서는 제어 신호($CS2_n$)가 하이 레벨로 되어 트랜지스터(M5)가 턴오프되고, 선택 신호(SE_n)가 로우 레벨로 되어 트랜지스터(M2)가 턴온된다. 턴온된 트랜지스터(M2)에 의해 데이터선(D_m)으로부터의 데이터 전류(I_{DATA})가 트랜지스터(M1)에 흐르게 되어, 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압($V_{GS}(T2)$)이 수학식 4와 같이 된다. 따라서 문턱 전압(V_{TH})을 충전하고 있던 커패시터(C1)의 전압(V_{C1})은 커패시터(C1, C2)의 커플링에 의해 수학식 7과 같이 된다.

<81>

【수학식 7】
$$V_{C1} = |V_{TH}| + \frac{C_2}{C_1 + C_2} (|V_{GS}(T2)| - |V_{TH}|)$$

<82>

다음, 구간(T3)에서는 하이 레벨의 제어 신호(CS1_n) 및 선택 신호(SE_n)에 응답하여 트랜지스터(M3, M2)가 턴오프되고, 로우 레벨의 제어 신호(CS2_n) 및 발광 신호(EM_n)에 의해 트랜지스터(M5, M4)가 턴온된다. 트랜지스터(M3)가 턴오프되고 트랜지스터(M5)가 턴온되면, 커패시터(C1)의 전압(V_{C1})이 구간(T3)에서의 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압(V_{GS}(T3))으로 된다. 따라서 트랜지스터(M1)에 흐르는 전류(I_{OLED})는 수학식 8과 같이 되고, 이 전류(I_{OLED})가 트랜지스터(M4)에 의해 유기 EL 소자(OLED)에 공급되어 발광이 이루어진다.

<83>

【수학식 8】
$$I_{OLED} = \frac{\beta}{2} \left\{ \frac{C_2}{C_1 + C_2} (|V_{GS}(T2)| - |V_{TH}|) \right\}^2 = \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^2 I_{DATA}$$

<84>

본 발명의 제5 실시예에서도 제1 실시예와 마찬가지로 유기 EL 소자(OLED)에 공급되는 전류(I_{OLED})는 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(V_{TH})이나 이동도에 관계없이 결정된다. 또한 전류(I_{OLED})에 대해 (C₁+C₂)/C₂의 제곱 배만큼 큰 데이터 전류(I_{DATA})로서 유기 EL 소자(OLED)에 흐르는 미세 전류를 제어할 수 있으므로, 고계조를 표현할 수 있다. 그리고 데이터선(D₁-D_M)에 큰 데이터 전류(I_{DATA})를 공급하므로 데이터선의 충전 시간을 충분히 확보할 수 있다.

<85>

본 발명의 제5 실시예에서는 트랜지스터(M1-M5)를 PMOS 트랜지스터로 구현하였지만, 이를 NMOS 트랜지스터로 구현할 수도 있다. 아래에서는 이러한 실시예에 대하여 도 14를 참조하여 설명한다.

<86>

도 14는 본 발명의 제6 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이다.

<87> 도 14에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제6 실시예에 따른 화소 회로는 트랜지스터(M1-M5)가 NMOS 트랜지스터로 구현되어 있으며, 그 연결 구조는 도 13의 화소 회로와 대칭을 이룬다. 도 14의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형은 도 13의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형의 반전된 형태를 가지며, 도 8의 구동 파형과 동일하다. 이러한 제6 실시예에 따른 화소 회로의 연결 구조 및 동작에 대해서는 제5 실시예의 설명으로부터 용이하게 알 수 있으므로 자세한 설명을 생략한다.

<88> 본 발명의 제1 내지 제6 실시예에서는 두 개의 제어 신호 또는 하나의 제어 신호를 사용하여 화소 회로를 제어하였지만, 이와는 달리 제어 신호를 사용하지 않고 이전 주사선의 선택 신호를 사용하여 화소 회로를 제어할 수도 있다. 아래에서는 이러한 실시예에 대하여 도 15 및 도 16을 참조하여 상세하게 설명한다.

<89> 도 15는 본 발명의 제7 실시예에 따른 화소 회로의 등가 회로도이며, 도 16은 도 15의 화소 회로를 구동하기 위한 구동 파형도이다.

<90> 도 15에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제7 실시예에 따른 화소 회로는 트랜지스터(M3, M5, M6, M7)를 제외하면 제1 실시예와 동일한 구조를 가진다. 자세하게 설명하면, 트랜지스터(M3)는 직전 주사선(S_{n-1})으로부터의 선택 신호(SE_{n-1})에 응답하여 트랜지스터(M1)를 다이오드 형태로 연결하며, 트랜지스터(M7)는 현재 주사선(S_n)으로부터의 선택 신호(SE_n)에 응답하여 트랜지스터(M1)를 다이오드 형태로 연결한다. 도 15에서 트랜지스터(M7)는 데이터선(D_m)과 트랜지스터(M1)의 게이트 사이에 연결되어 있지만, 트랜지스터(M1)의 게이트와 드레인 사이에 연결될 수도 있다. 그리고 트랜지스터(M5, M6)는 커패시터(C2)와 트랜지스터

(M1)의 게이트 사이에 병렬로 연결된다. 트랜지스터(M5)는 직전 주사선(S_{n-1})으로부터의 선택 신호(SE_{n-1})에 응답하고, 트랜지스터(M6)는 주사선(E_n) 으로부터의 발광 신호(EM_n)에 응답한다.

<91> 다음, 도 16을 참조하여 도 15의 화소 회로의 동작에 대하여 상세하게 설명한다.

<92> 도 16을 보면, 먼저 구간(T1)에서는 로우 레벨의 선택 신호(SE_{n-1})에 의해 트랜지스터(M3, M5)가 턴온된다. 턴온된 트랜지스터(M5)에 의해 커패시터(C1, C2)는 트랜지스터(M1)의 게이트와 소스 사이에서 병렬 연결된다. 그리고 턴온된 트랜지스터(M3)에 의해 트랜지스터(M1)는 다이오드 형태로 연결되어, 병렬 연결된 커패시터(C1, C2)에는 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(V_{TH})이 저장된다. 그리고 하이 레벨의 선택 신호(SE_n) 및 발광 신호(EM_n)에 의해 트랜지스터(M2, M7, M4, M6)는 턴오프되어 있다.

<93> 구간(T2)에서는 선택 신호(SE_{n-1})가 하이 레벨이 되어 트랜지스터(M3)가 턴오프되지만, 로우 레벨의 선택 신호(SE_n)에 의해 트랜지스터(M7)가 턴온되어 트랜지스터(M1)는 다이오드 형태로 연결된 상태로 유지된다. 선택 신호(SE_{n-1})에 의해 트랜지스터(M5)가 턴오프되어 커패시터(C2)는 전압이 저장된 상태에서 플로팅된다. 그리고 선택 신호(SE_n)에 의해 트랜지스터(M2)가 턴온되어 데이터선(D_m)으로부터의 데이터 전류(I_{DATA})가 트랜지스터(M1)에 흐르게 된다. 그러면 데이터 전류(I_{DATA})에 대응하여 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압(V_{GS}

(T2))이 결정되고, 게이트-소스 전압($V_{GS}(T2)$)은 제1 실시예에서와 동일하게 수학식 4로 주어진다.

<94> 다음, 구간(T3)에서는 선택 신호(SE_n)가 하이 레벨로 되어 트랜지스터(M2, M7)가 턴오프되고, 로우 레벨의 발광 신호(EM_n)에 의해 트랜지스터(M4, M6)가 턴온된다. 트랜지스터(M6)가 턴온되면 커패시터(C1, C2)의 커플링에 의해 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압($V_{GS}(T3)$)은 제1 실시예에서와 동일하게 수학식 5로 주어진다. 따라서 수학식 6에 나타낸 전류(I_{OLED})가 턴온된 트랜지스터(M4)에 의해 유기 EL 소자(OLED)에 공급되어 발광이 이루어진다.

<95> 본 발명의 제7 실시예에서는 제어 신호($CS1_n$, $CS2_n$)를 제거하였지만, 이와는 달리 제어 신호($CS1_n$, $CS2_n$) 중 하나를 제거할 수도 있다. 자세하게 설명하면, 본 발명의 제7 실시예에서 제어 신호($CS1_n$)를 추가로 사용하는 경우에는, 도 15의 화소 회로에서 트랜지스터(M7)를 빼고 트랜지스터(M3)를 선택 신호(SE_{n-1}) 대신에 제어 신호($CS1_n$)로 구동하면 된다. 그리고 본 발명의 제7 실시예에서 제어 신호($CS2_n$)를 추가로 사용하는 경우에는, 도 15의 화소 회로에서 트랜지스터(M6)를 빼고 트랜지스터(M5)를 선택 신호(SE_{n-1})와 발광 신호(EM_n) 대신에 제어 신호($CS2_n$)로 구동할 수 있다. 이와 같이 하면, 도 15에 비해 배선의 수는 증가하지만 트랜지스터의 개수를 줄일 수 있다.

<96> 이상, 본 발명의 제1 내지 제7 실시예에서는 PMOS 및/또는 NMOS 트랜지스터를 사용하여 화소 회로를 구현하였지만, 이에 한정되지 않고 PMOS, NMOS 또는 PMOS와 NMOS의 조합으로 화소 회로를 구현할 수 있으며, 또한 유사한 기능을 하는 다른 스위칭 소자를 사용하여 화소 회로를 구현할 수도 있다.

<97> 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

【발명의 효과】

<98> 이와 같이 본 발명에 의하면, 큰 데이터 전류로서 유기 EL 소자에 흐르는 전류를 제어할 수 있으므로, 한 라인 시간동안 데이터선을 충분히 충전할 수 있다. 또한, 유기 EL 소자에 흐르는 전류는 트랜지스터의 문턱 전압 편차나 이동도의 편차가 보상되며, 고해상도와 대면적의 발광 표시 장치가 구현될 수 있다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

화상 신호를 나타내는 데이터 전류를 전달하는 복수의 데이터선, 선택 신호를 전달하는 복수의 주사선, 그리고 상기 데이터선과 상기 주사선에 의해 정의되는 복수의 화소에 각각 형성되는 복수의 화소 회로가 형성되어 있는 표시 패널을 포함하는 발광 표시 장치에 있어서,

상기 화소 회로는,

인가되는 전류에 대응하여 빛을 발광하는 발광 소자,

상기 발광 소자를 발광시키기 위한 구동 전류를 공급하며 제1 및 제2 주전극(main electrode)과 제어 전극을 가지는 제1 트랜지스터,

제1 제어 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키는 제1 스위칭 소자,

제 2 제어 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압을 저장하는 제1 저장 소자,

상기 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 데이터선으로부터의 데이터 신호를 전달하는 제2 스위칭 소자,

상기 제1 스위칭 소자로부터의 상기 데이터 전류에 대응하는 제2 전압을 저장하는 제2 저장 소자, 그리고

제3 제어 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터로부터의 상기 구동 전류를 상기 발광 소자로 전달하는 제3 스위칭 소자

를 포함하며,

상기 제1 및 제2 전압을 각각 저장하고 있는 상기 제1 및 제2 저장 소자의 커플링에 의해 결정된 제3 전압이 상기 제1 트랜지스터에 인가되어 상기 구동 전류가 상기 발광 소자에 공급되는 발광 표시 장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 제2 제어 신호, 상기 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호 순으로 인에이블되는 발광 표시 장치.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 제1 내지 제3 스위칭 소자 및 상기 제1 트랜지스터는 동일 전도 타입의 트랜지스터인 발광 표시 장치.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 제1 내지 제3 스위칭 소자 중 적어도 하나의 스위칭 소자는 상기 제1 트랜지스터와 반대되는 전도 타입의 트랜지스터인 발광 표시 장치.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 화소 회로는 상기 제2 제어 신호에 응답하여 턴온되며 제1단이 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극에 연결되는 제4 스위칭 소자를 더 포함하며,

상기 제2 저장 소자는 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 연결되는 제1 커패시터에 의해 형성되며, 상기 제1 저장 소자는 상기 제1 트랜지스터의 제1 주 전극과 상기 제4 스위칭 소자의 제2단 사이에 연결되는 제2 커패시터와 상기 제1 커패시터의 병렬 연결에 의해 형성되는 발광 표시 장치.

【청구항 6】

제5항에 있어서,
상기 제2 제어 신호는 상기 주사선으로부터의 상기 선택 신호이며,
상기 제4 스위칭 소자는 상기 선택 신호의 디스에이블 구간에서 응답하는 발광 표시 장치.

【청구항 7】

제5항에 있어서,
상기 제1 제어 신호는 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 현재 주사선으로부터의 선택 신호를 포함하는 발광 표시 장치.

【청구항 8】

제7항에 있어서,
상기 제1 스위칭 소자는, 상기 이전 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키는 제2 트랜지스터 및 상기 현재 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키는 제3 트랜지스터를 포함하는 발광 표시 장치.

【청구항 9】

제5항에 있어서,

상기 제2 제어 신호는 상기 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호를 포함하는 발광 표시 장치.

【청구항 10】

제9항에 있어서,

상기 화소 회로는 상기 제4 스위칭 소자에 병렬로 연결되는 제5 스위칭 소자를 더 포함하며,

상기 제4 및 제5 스위칭 소자는 각각 상기 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호에 응답하여 턴온되는 발광 표시 장치.

【청구항 11】

제5항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 현재 주사선으로부터의 선택 신호를 포함하며, 상기 제2 제어 신호는 상기 이전 주사선으로부터의 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호를 포함하는 발광 표시 장치.

【청구항 12】

제1항에 있어서,

상기 화소 회로는 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극에 제1단이 연결되며 상기 제2 제어 신호에 응답하는 제4 스위칭 소자를 더 포함하며,

상기 제1 저장 소자는 상기 제4 스위칭 소자의 제2단과 상기 제1 트랜지스터의 제1 주 전극 사이에 연결되는 제1 커패시터에 의해 형성되며,

상기 제2 저장 소자는 상기 제4 스위칭 소자의 제2단과 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극 사이에 연결되는 제2 커패시터와 상기 제1 커패시터의 직렬 연결에 의해 형성되는 발광 표시 장치.

【청구항 13】

제1항에 있어서,

상기 선택 신호, 상기 제1 내지 제3 제어 신호를 공급하는 제1 구동 회로, 그리고 상기 데이터 전류를 공급하는 제2 구동 회로를 더 포함하며,

상기 제1 및 제2 구동 회로는 상기 표시 패널에 연결되어 있거나, 상기 표시 패널의 기판 위에 집적 회로 칩의 형태로 장착되어 있거나, 상기 기판 위에 상기 주사선, 상기 데이터선 및 상기 제1 스위칭 소자와 동일한 층들로 직접 형성되어 있는 발광 표시 장치.

【청구항 14】

화상 신호를 나타내는 데이터 전류를 전달하는 복수의 데이터선, 선택 신호를 전달하는 복수의 주사선, 그리고 상기 데이터선과 상기 주사선에 의해 정의되는 복수의 화소에 각각 형성되는 복수의 화소 회로가 형성되어 있는 발광 표시 장치의 표시 패널에 있어서,

상기 화소 회로는,

제1 전압을 공급하는 제1 전원에 제1 주 전극이 연결되는 제1 트랜지스터,

상기 제1 트랜지스터의 제2 주 전극과 상기 데이터선에 사이에 연결되며
상기 주사선으로부터의 제1 선택 신호에 의해 제어되는 제1 스위칭 소자,

상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키도록 제1 제어 신호에 의
해 제어되는 제2 스위칭 소자,

상기 제1 트랜지스터의 제어 전극에 제1단이 연결되며 제2 제어 신호에 의
해 제어되는 제3 스위칭 소자,

상기 제1 트랜지스터의 제2 주 전극에 제1단이 연결되며 제3 제어 신호에
의해 제어되는 제4 스위칭 소자,

인가되는 전류에 대응하여 빛을 발광하며 상기 제4 스위칭 소자의 제2단과
제2 전압을 공급하는 제2 전원 사이에 연결되는 발광 소자,

상기 제3 스위칭 소자가 온 상태일 때 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극과
제1 주 전극 사이에 연결되는 제1 저장 소자, 그리고

상기 제3 스위칭 소자가 오프 상태일 때 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극
과 제1 주 전극 사이에 연결되는 제2 저장 소자
를 포함하는 표시 패널.

【청구항 15】

제14항에 있어서,

상기 제2 저장 소자는 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사
이에 연결되는 제1 커패시터를 포함하며,

상기 제1 저장 소자는 상기 제1 트랜지스터의 제1 주 전극과 상기 제3 스위칭 소자의 제2단 사이에 연결되는 제2 커패시터와 상기 제1 커패시터의 병렬 연결에 의해 형성되는 표시 패널.

【청구항 16】

제15항에 있어서,

상기 제1 내지 제3 제어 신호는 각각 제1 내지 제3 신호선에 의해 공급되며, 상기 표시 패널은 상기 제1 내지 제3 신호선을 더 포함하는 표시 패널

【청구항 17】

제16항에 있어서,

상기 화소 회로는 제1, 제2 및 제3 구간 순으로 구동되며,

상기 제1 구간에서는 상기 제1 및 제2 제어 신호가 인에이블 구간을 가지며

상기 제2 구간에서는 상기 제1 제어 신호 및 상기 제1 선택 신호가 인에이블 구간을 가지며,

상기 제3 구간에서는 상기 제2 및 제3 제어 신호가 인에이블 구간을 가지는 표시 패널.

【청구항 18】

제15항에 있어서,

상기 제2 제어 신호는 상기 주사선으로부터의 상기 제1 선택 신호이며, 상기 제3 스위칭 소자는 상기 선택 신호의 디스에이블 구간에서 턴온되는 표시 패널.

【청구항 19】

제18항에 있어서,

상기 화소 회로는 제1, 제2 및 제3 구간 순으로 구동되며,

상기 제1 구간에서는 상기 제1 제어 신호가 인에이블 구간을 가지며,

상기 제2 구간에서는 상기 제1 제어 신호 및 상기 제1 선택 신호가 인에이블 구간을 가지며,

상기 제3 구간에서는 상기 제3 제어 신호가 인에이블 구간을 가지는 표시 패널.

【청구항 20】

제19항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 상기 제1 선택 신호가 인에이블되는 시점에 디스에이블 구간을 가지는 표시 패널.

【청구항 21】

제15항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는, 상기 제1 선택 신호 및 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 구간을 가지는 이전 주사선으로부터의 제2 선택 신호를 포함하며,

상기 제2 스위칭 소자는, 상기 제2 및 제1 선택 신호에 각각 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키는 제2 및 제3 트랜지스터를 포함하는 표시 패널.

【청구항 22】

제15항에 있어서,

상기 제2 제어 신호는, 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 구간을 가지는 이전 주사선으로부터의 제2 선택 신호와 상기 제3 제어 신호를 포함하며,

상기 제3 스위칭 소자는, 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극과 상기 제2 커패시터 사이에 연결되며 상기 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호에 각각 응답하는 제2 및 제3 트랜지스터를 포함하는 표시 패널.

【청구항 23】

제15항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 상기 제1 선택 신호 및 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 구간을 가지는 이전 주사선으로부터의 제2 선택 신호를 포함하며, 상기 제2 제어 신호는 상기 제2 선택 신호와 상기 제3 제어 신호를 포함하며,

상기 제2 스위칭 소자는, 상기 제2 및 제1 선택 신호에 각각 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 형태로 연결시키는 제2 및 제3 트랜지스터를 포함하며, 상기 제3 스위칭 소자는, 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극과 상기 제2 커패시터 사이에 연결되며 상기 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호에 각각 응답하는 제4 및 제5 트랜지스터를 포함하는 표시 패널.

【청구항 24】

제14항에 있어서,

상기 제1 저장 소자는 상기 제1 트랜지스터의 제1 주 전극과 상기 제3 스위칭 소자의 제2단 사이에 연결되는 제1 커패시터를 포함하며,

상기 제2 저장 소자는 상기 제1 트랜지스터의 제어 전극과 상기 제3 스위칭 소자의 제2단 사이에 연결되는 제2 커패시터와 상기 제1 커패시터의 직렬 연결에 의해 형성되는 표시 패널.

【청구항 25】

주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 데이터선으로부터의 데이터 전류를 전달하는 스위칭 소자, 상기 데이터 전류에 대응하여 구동 전류를 출력하며 제1 및 제2 주 전극과 제어 전극을 가지는 트랜지스터, 그리고 상기 트랜지스터로부터의 구동 전류에 대응하여 빛을 발광하는 발광 소자를 포함하는 화소 회로가 형성되어 있는 발광 표시 장치를 구동하는 방법에 있어서,

상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 형성되는 제1 저장 소자에 상기 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압을 저장하는 제1 단계,

상기 스위칭 소자로부터의 데이터 전류에 대응하는 제2 전압을 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 형성되는 제2 저장 소자에 저장하는 제2 단계, 그리고

상기 제1 및 제2 저장 소자를 컵플링하여 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이의 전압을 제3 전압으로 하고, 상기 트랜지스터로부터의 구동 전류를 상기 발광 소자로 전달하는 제3 단계를 포함하며,

상기 트랜지스터로부터의 구동 전류는 상기 제3 전압에 대응하여 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 26】

제25항에 있어서,

상기 제1 단계에서 상기 제1 저장 소자는 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 병렬로 연결되는 제1 및 제2 컵패시터를 포함하며,

상기 제2 단계에서 상기 제2 저장 소자는 상기 제1 컵패시터를 포함하며,

상기 제3 단계에서 상기 제3 전압은 상기 제1 및 제2 컵패시터의 병렬 연결에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 27】

제25항에 있어서,

상기 제1 단계에서 상기 제1 저장 소자는 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 연결되는 제1 컵패시터를 포함하며,

상기 제2 단계에서 상기 제2 저장 소자는 상기 제1 컵패시터 및 상기 제1 컵패시터와 상기 트랜지스터의 제어 전극 사이에 연결되는 제2 컵패시터를 포함하며,

상기 제3 단계에서 상기 제3 전압은 상기 제1 커패시터에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 28】

주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 데이터선으로부터의 데이터 전류를 전달하는 스위칭 소자, 상기 데이터 전류에 대응하여 구동 전류를 출력하며 제1 및 제2 주 전극과 제어 전극을 가지는 트랜지스터, 그리고 상기 트랜지스터로부터의 구동 전류에 대응하여 빛을 발광하는 발광 소자를 포함하는 화소 회로가 형성되어 있는 발광 표시 장치를 구동하는 방법에 있어서,

제 1 제어 신호에 응답하여 상기 트랜지스터가 다이오드 형태로 연결되며, 제2 제어 신호의 제1 레벨에 응답하여 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 제1 저장 소자가 연결되어 상기 제1 저장 소자에 상기 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압이 저장되는 제1 단계,

상기 제1 제어 신호에 의해 트랜지스터는 다이오드 형태로 연결되어 있으며, 상기 제2 제어 신호의 제2 레벨에 응답하여 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 제2 저장 소자가 연결되고, 상기 주사선으로부터의 제1 선택 신호에 응답하여 상기 제2 저장 소자에 상기 데이터 전류에 대응하는 제2 전압이 저장되는 제2 단계, 그리고

상기 제2 제어 신호의 제1 레벨에 응답하여 상기 제1 및 제2 저장 소자가 커플링되어 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이의 전압이 제3 전압으로 되며, 상기 트랜지스터에는 상기 제3 전압에 대응하는 구동 전류가 흐르고,

제3 제어 신호에 응답하여 상기 구동 전류가 상기 발광 소자로 공급되는 제3 단계

를 포함하는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 29】

제28항에 있어서,

상기 제3 단계에서 상기 제2 제어 신호의 제1 레벨에 응답하여 상기 제1 저장 소자가 상기 트랜지스터의 제어 전극과 제1 주 전극 사이에 연결되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 30】

제28항에 있어서,

상기 제1 내지 제3 제어 신호는 상기 주사선과는 별도의 제1 내지 제3 신호선에 의해 각각 전달되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 31】

제28항에 있어서,

상기 제2 제어 신호는 상기 제1 선택 신호이며, 상기 제2 제어 신호의 제1 레벨은 상기 제1 선택 신호의 디스에이블 레벨인 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 32】

제31항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 상기 제1 선택 신호가 인에이블 레벨로 되는 순간에 디스에이블 구간을 가지는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 33】

제28항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 상기 제1 선택 신호 및 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 구간을 가지는 이전 주사선으로부터의 제2 선택 신호를 포함하며,

상기 트랜지스터는 상기 제1 및 제2 단계에서 각각 상기 제2 및 제1 선택 신호에 의해 다이오드 형태로 연결되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 34】

제28항에 있어서,

상기 제2 제어 신호는 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 구간을 가지는 이전 주사선으로부터의 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호를 포함하며,

상기 제1 및 제3 단계에서의 상기 제2 제어 신호의 제1 레벨은 각각 상기 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 35】

제28항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 상기 제1 선택 신호 및 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 구간을 가지는 이전 주사선으로부터의 제2 선택 신호를 포함하며,

상기 제2 제어 신호는 상기 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호를 포함하며,

상기 트랜지스터는 상기 제1 및 제2 단계에서 각각 상기 제2 및 제1 선택 신호에 의해 다이오드 형태로 연결되며,

상기 제1 및 제3 단계에서의 상기 제2 제어 신호의 제1 레벨은 각각 상기 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 36】

제1 선택 신호에 응답하여 화상 신호를 나타내는 데이터 전류를 트랜지스터로 전달하여 발광 소자를 구동하는 방법에 있어서,

제 1 및 제2 스위칭 소자에 각각 인가되는 제1 및 제2 제어 신호를 인에이블 레벨로 하여 상기 트랜지스터의 문턱 전압에 대응하는 제1 전압을 저장하고, 제3 스위칭 소자에 인가되는 제3 제어 신호를 디스에이블 레벨로 하여 상기 트랜지스터와 상기 발광 소자를 전기적으로 차단하고, 제4 스위칭 소자에 인가되는 상기 제1 선택 신호를 디스에이블 레벨로 하여 상기 데이터 전류를 차단하는 제1 단계,

상기 제1 선택 신호를 인에이블 레벨로 하여 상기 데이터 전류를 공급하고, 상기 제1 및 제2 제어 신호를 각각 인에이블 및 디스에이블 레벨로 하여 상기 데이터 전류에 대응하는 제2 전압을 저장하는 제2 단계, 그리고

상기 제1 선택 신호를 디스에이블 레벨로 하여 상기 데이터 전류를 차단하고, 상기 제1 및 제2 제어 신호를 각각 디스에이블 및 인에이블로 하여 제3 전압을 상기 트랜지스터의 주 전극과 게이트 전극에 인가하고, 상기 제3 제어 신호를

인에이블로 하여 상기 트랜지스터로부터의 전류를 상기 발광 소자로 전달하는

제3 단계

를 포함하며,

상기 제3 전압은 상기 제1 및 제2 전압에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 37】

제36항에 있어서,

상기 제2 제어 신호는 상기 제1 선택 신호에 의해 결정되며, 상기 제2 제어 신호는 상기 제1 선택 신호와 반대 레벨을 가지는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 38】

제36항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 상기 제1 선택 신호 및 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 레벨로 되며 상기 제1 제어 신호가 인에이블 레벨로 된 이후에는 디스에이블 레벨로 되는 제2 선택 신호에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 39】

제36항에 있어서,

상기 제2 제어 신호는 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 레벨로 되며 상기 제1 제어 신호가 인에이블 레벨로 된 이후에는 디스에이블 레벨로 되는 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【청구항 40】

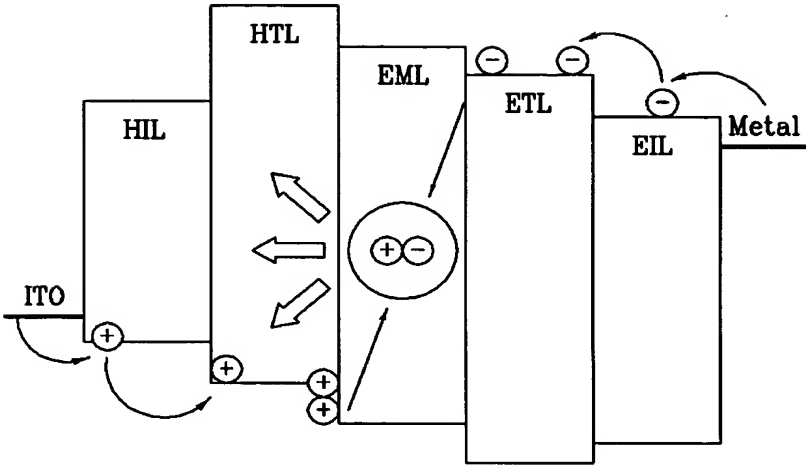
제36항에 있어서,

상기 제1 제어 신호는 상기 제1 선택 신호 및 상기 제1 선택 신호보다 먼저 인에이블 레벨로 되며 상기 제1 제어 신호가 인에이블 레벨로 된 이후에는 디스에이블 레벨로 되는 제2 선택 신호에 의해 결정되며,

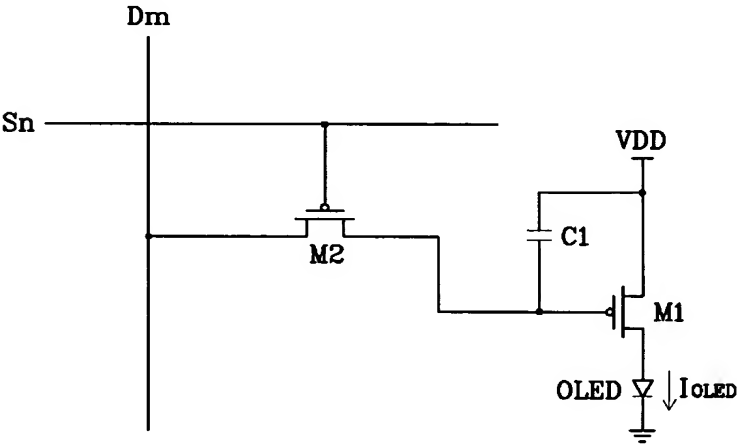
상기 제2 제어 신호는 상기 제2 선택 신호 및 상기 제3 제어 신호에 의해 결정되는 발광 표시 장치의 구동 방법.

【도면】

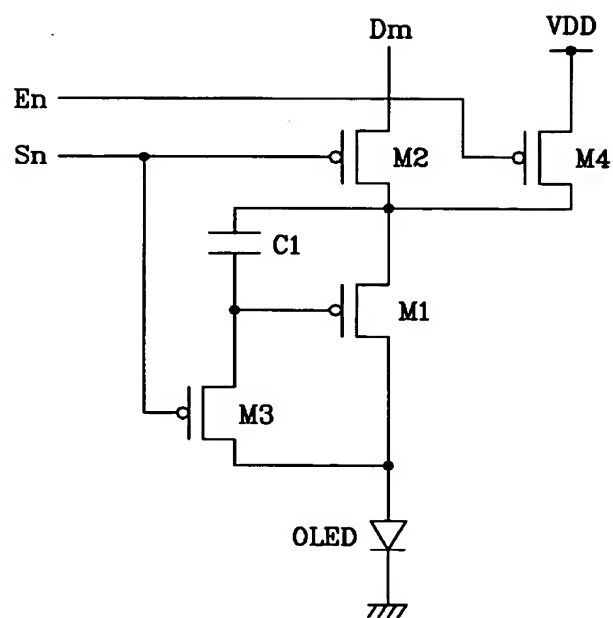
【도 1】



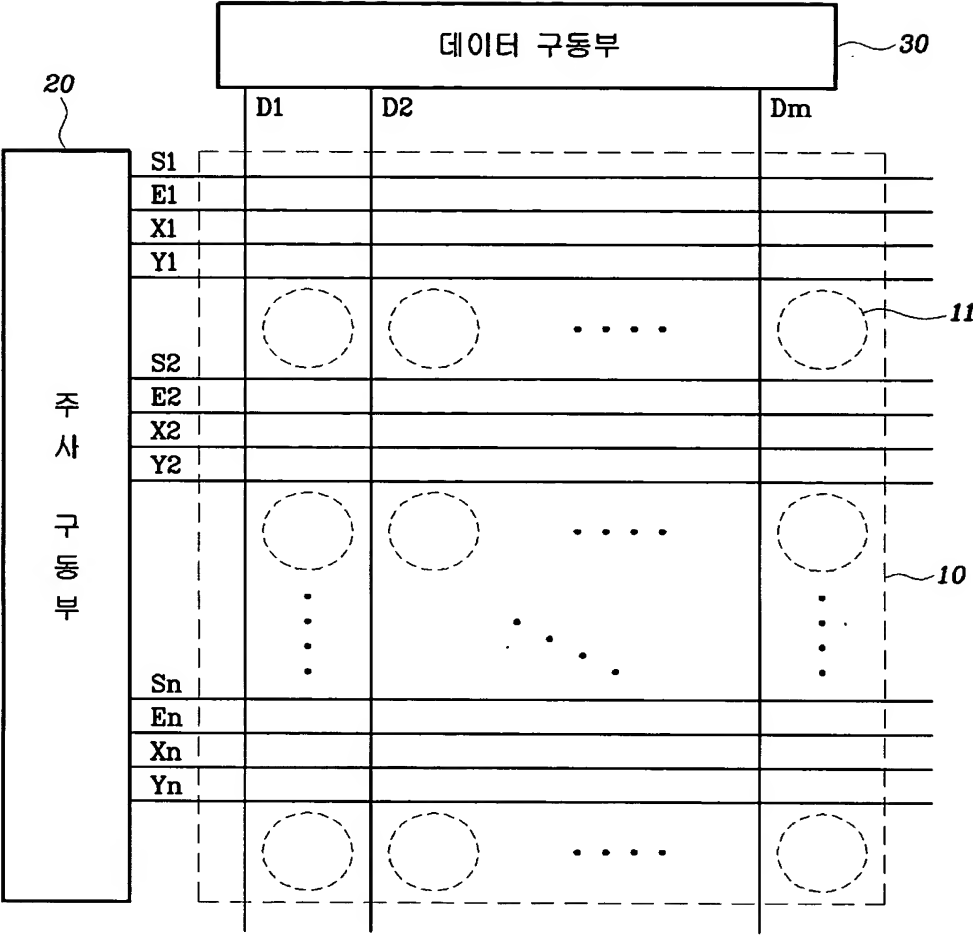
【도 2】



【도 3】



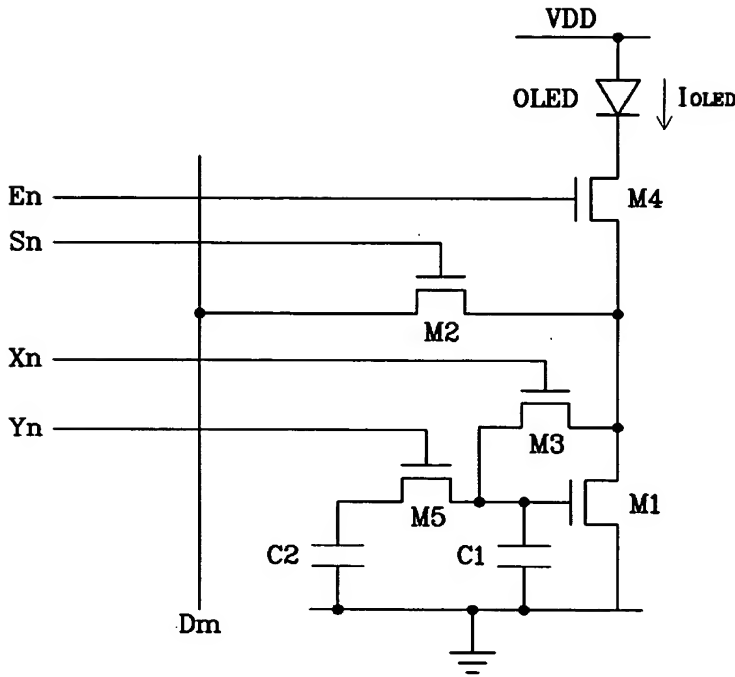
【도 4】



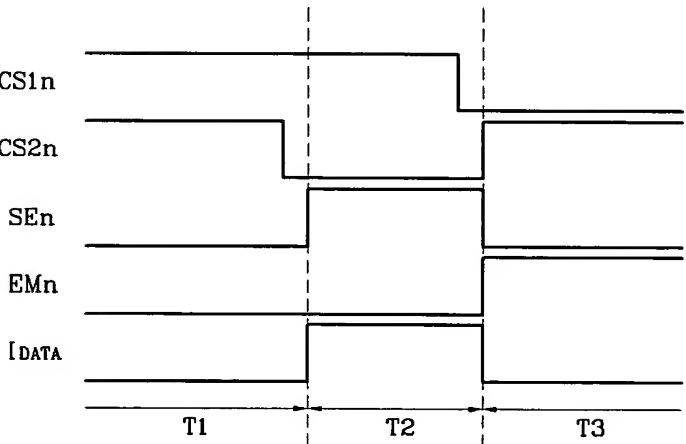
The timing diagram illustrates the sequence of signals for the 24C02 during a write operation. The signals are CS1n, CS2n, SEn, EMn, and I DATA. The time axis is divided into three periods: T1, T2, and T3, separated by vertical dashed lines.

- T1:** CS1n is low, CS2n is high, SEn is high, EMn is low, and I DATA is low.
- T2:** CS1n transitions to high, CS2n transitions to low, SEn transitions to low, EMn transitions to high, and I DATA transitions to high.
- T3:** All signals return to their initial states: CS1n is high, CS2n is high, SEn is high, EMn is low, and I DATA is low.

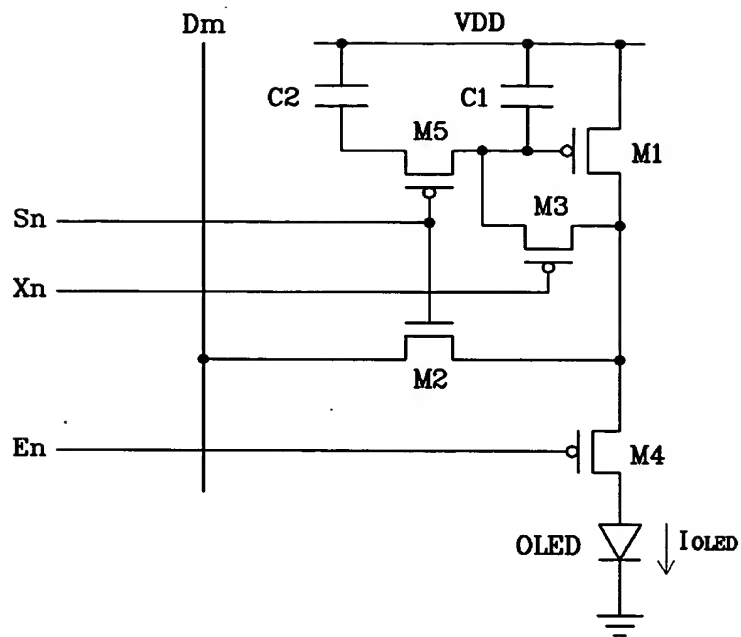
【도 7】



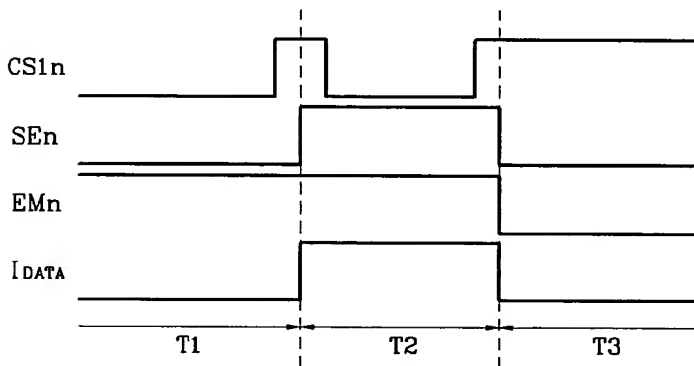
【도 8】



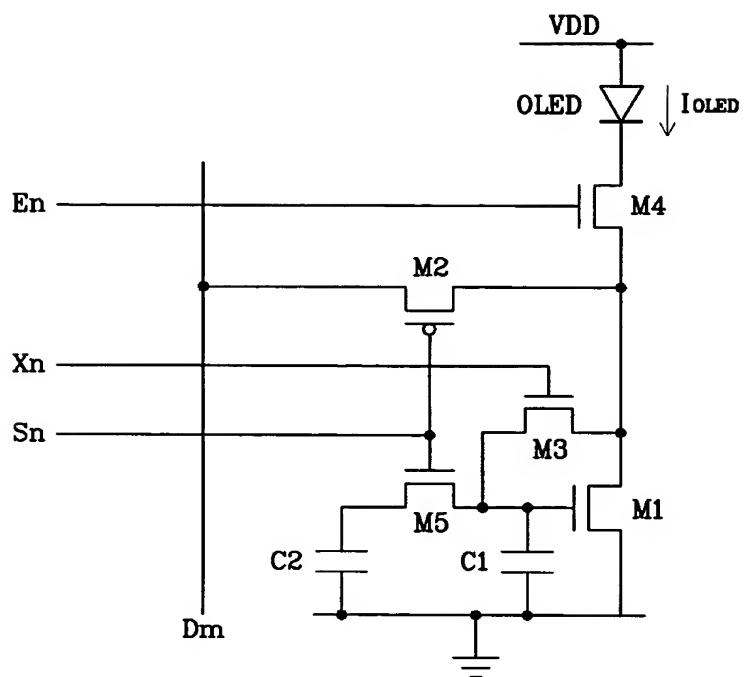
【도 9】



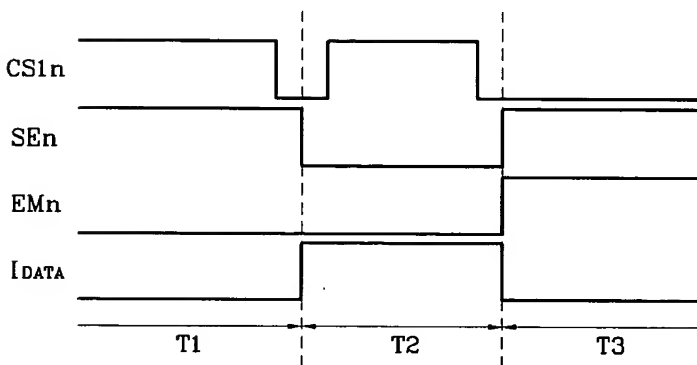
【도 10】



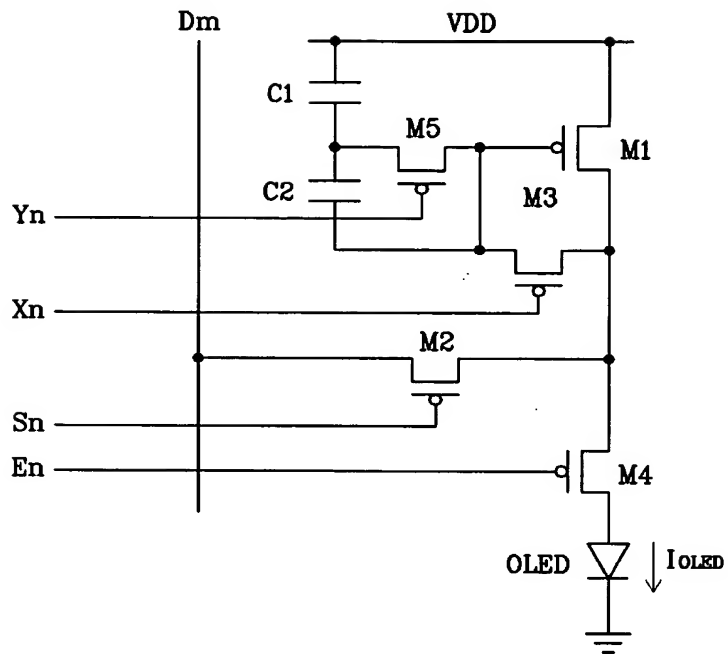
【도 11】



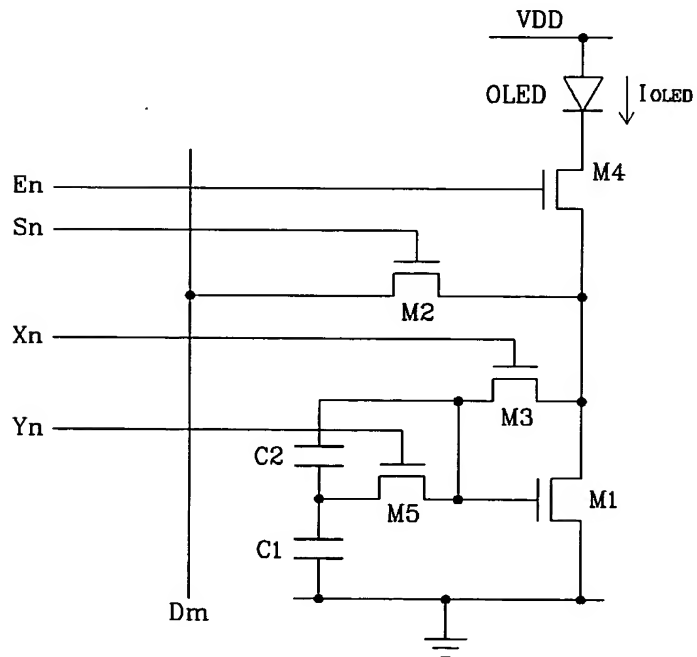
【도 12】



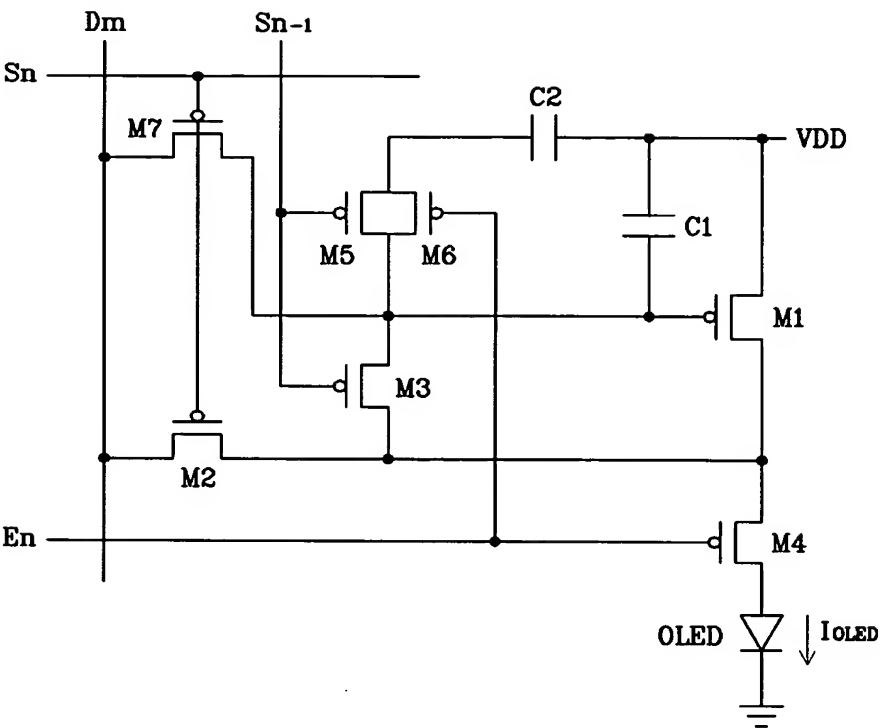
【도 13】



【도 14】



【도 15】



【도 16】

